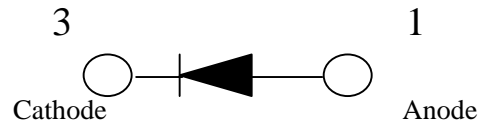




## Schottky Diode (FHBAS40)

### 肖特基二极管



### MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	$V_R$	40	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	$I_F$	350	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流 t 1s	$I_{FM(surge)}$	1.5	Adc

### THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	$P_D$	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	$P_D$	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	$T_J, T_{stg}$	150 , -55 to +150	

### DEVICE MARKING 打标

FHBAS40=5S

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性( $T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25 )

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

### OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流( $V_R=25Vdc$ )	$I_R$	—	1.0	$\mu A_{dc}$
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压( $I_{BR}=10 \mu A_{dc}$ )	$V_{(BR)}$	40	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ( $I_F=20mAdc$ ) ( $I_F=200mAdc$ )	$V_F$	—	370 600	mVdc
Total Capacitance 电容( $V_R=1V, f=1.0MHz$ )	$C_T$	—	5	pF



## SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

